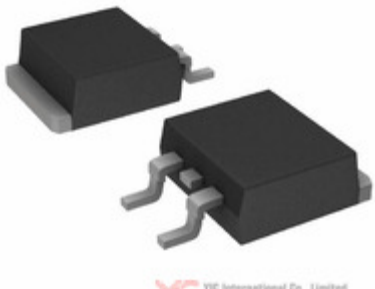








	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB029N06N3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB029N06N3 G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB029N06N3 G.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 19500 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB029N06N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB029N06N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	19500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 118µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.9 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	188W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	165nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPB029N06N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB029N06N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB029N06N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB029N06N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB029N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB030N08N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 160A TO263-7</p>	 <p>IPB027N10N3 G INFINEON IPB027N10N3 G INFINEON</p>	 <p>IPB026N06NATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 25A TO263-3</p>
 <p>IPB027N10N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 120A D2PAK-3</p>	 <p>IPB029N06N3G(032N06N) INFINEON IPB029N06N3G(032N06N) INFINEON</p>	 <p>IPB027N10N3G INFINEO IPB027N10N3G INFINEO</p>	 <p>IPB029N06N3GE8187ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB029N06N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB029N06N3 G Datenblatt	IPB029N06N3 G-Datenblätter	IPB029N06N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB029N06N3 G
IPB029N06N3 G Electronic	IPB029N06N3 G-Komponenten	IPB029N06N3 G-Verteiler	IPB029N06N3 G-Bild	IPB029N06N3 G-Teil
IPB029N06N3 G Preis	IPB029N06N3 G Hersteller	IPB029N06N3 G Bild	IPB029N06N3 G Aktie	IPB029N06N3 G Inventar
IPB029N06N3 G Neu	IPB029N06N3 G Original	IPB029N06N3 G garantiert	IPB029N06N3 G RFQ	IPB029N06N3 G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited